(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

特開平11-204859

(43)公開日 平成11年(1999)7月30日

(51) Int.CL ⁶		識別記号	FΙ		
H01S	3/07		H01S	3/07	
	3/10			3/10	Z
	3/17			3/17	

審査請求 未請求 請求項の数8 OL (全 18 頁)

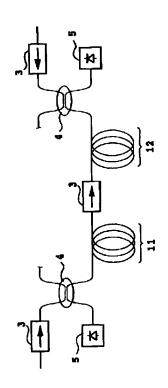
(21)出願番号	特顧平10-6970	(71) 出願人 000004226
		日本電信電話株式会社
(22)出顧日	平成10年(1998) 1 月16日	東京都新宿区西新宿三丁目19番2号
		(72)発明者 西田 好數
		東京都新宿区西新宿三丁目19番2号 日本
		電信電話株式会社内
		(72)発明者 山田 誠
		東京都新宿区西新宿三丁目19番2号 日本
		電信電話株式会社内
		(72)発明者 金森 照寿
		東京都新宿区西新宿三丁目19番2号 日本
		電信電話株式会社内
		(74)代理人 弁理士 谷 義一 (外1名)
		最終頁に統く

(54) 【発明の名称】 光ファイパ増幅器

(57)【要約】

【課題】 低雑音で広帯域な光ファイバ増幅器を提供する.

【解決手段】 希土類イオンが添加された複数の光増幅 用ファイバが直列または並列に接続された構成を有する 光ファイバ増幅器において、前記光増幅用光ファイバ を、フッ化物光ファイバ、テルライトファイバ、カルコ ゲナイドファイド、石英系ファイバのいずれかから構成 する。あるいは、希土類イオンが添加された第1の光増 幅用ファイバと第2の光増幅用ファイバとをアイソレー 夕を介して直列に接続し、前記第1の光増幅用光ファイ バを信号光の進行方向に対して前記アイソレータの前段 に位置させるとともに、前記第2の光増幅用ファイバを 前記アイソレータの後段に位置させ、前記第1の光増幅 用ファイバをカルコゲナイドファイバあるいはテルライ トファイバから構成し、前記第2の光増幅用光ファイバ をフッ化物光ファイバから構成する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 希土類イオンが添加された複数の光増幅 用ファイバが、直列または並列に接続された構成を有す る光ファイバ増幅器において、

前記光増幅用ファイバが、フッ化物光ファイバ、テルラ イトファイバ、カルコゲナイドファイド、石英系ファイ バのいずれかからなることを特徴とする光ファイバ増幅

【請求項2】 希土類イオンが添加された第1の光増幅 用ファイバと第2の光増幅用ファイバとがアイソレータ 10 を介して直列に接続され、前記第1の光増幅用ファイバ は信号光の進行方向に対して前記アイソレータの前段に 位置するとともに、前記第2の光増幅用ファイバは前記 アイソレータの後段に位置し、前記第1の光増幅用ファ イバはカルコゲナイドファイバあるいはテルライトファ イバからなり、前記第2の光増幅用光ファイバはフッ化 物光ファイバからなることを特徴とする光ファイバ増幅

【請求項3】 前記希土類イオンがPr, Dy, Ndか らなることを特徴とする請求項1または2のいずれかに 20 記載の光ファイバ増幅器。

【請求項4】 前記フッ化物光ファイバのガラス組成 が、原子モル分率で、InF3 が10~30モル%、G aF3 が7~30モル%、ZnF2 が10~19モル %、BaF2 が4~30モル%、SrF2 が0~24モ ル%、PbF2 が0~30モル%、LaF3, YF3, GdF3, LuF3 よりなる群から選ばれた少なくとも 一種が1.5~10モル%、LiFが1.5~30モル %、NaFが0~30モル%、追加成分が0~15モル %であり、かつこれら組成量の合計が100モル%とな 30 っていることを特徴とする請求項1または2のいずれか に記載の光ファイバ増幅器。

【請求項5】 前記フッ化物光ファイバのガラス組成 が、原子モル分率で、InF3 が5~25モル%、Ga F3 が13~40モル%、ZnF2 が4~25モル%、 PbF2 が30~46モル%、CdF2 が0~20モル %、LaF3, YF3、GDF3, LuF3 よりなる群 から選ばれた少なくとも一種が1.5~12モル%、追 加成分が0~15モル%であり、かつこれら組成量の合 計が100モル%となっていることを特徴とする請求項 40 1または2のいずれかに記載の光ファイバ増幅器。

【請求項6】 前記フッ化物光ファイバのガラス組成 が、ZrF4 とHfF4 からなる群から選ばれた少なく とも一種が3~60モル%、BaFz が6~28モル %、LaF3 が1.5~6モル%、ScF3, YF3, GdF3, LuF3 からなる群から選ばれた少なくとも 一種が1.5~6モル%、AIF3 が1.5~6モル %、PbF2が0~25モル%、LiFおよびNaFか ら選ばれた少なくとも一種が3~25モル%、追加成分

00モル%となっていることを特徴とする請求項1また は2のいずれかに記載の光ファイバ増幅器。

【請求項7】 前記テルライトファイバのガラス組成 が、TeO2 が55~90モル%、ZnO, WO3, L i 2 O, Na2 O, Al2 O3, Bi2 O3 からなる群 から選ばれた少なくとも二種がそれぞれ0~35モル% であり、かつこれら組成量の合計が100モル%となっ ていることを特徴とする請求項1または2のいずれかに 記載の光ファイバ増幅器。

【請求項8】 前記カルコゲナイドファイバのガラス組 成が、カチオンとしてGa, Ge, In, La, Na, Li、K、Csからなる群から選ばれた少なくとも一種 を含有し、アニオンとしてS, C1, I, Brからなる 群から選ばれた少なくとも一種を含有していることを特 徴とする請求項1または2のいずれかに記載の光ファイ バ増幅器。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、光通信システム等 で使用される光ファイバ増幅器に関するものであり、特 に、広帯域、低雑音特性に優れる1.3μm帯光ファイ バ増幅器に関するものである。

[0002]

【従来の技術】近年、光ファイバ通信の大容量、高速化 に向けた光デバイスの研究開発が、精力的に行われてい る。中でも、光ファイバ増幅器は、光ファイバ線路を伝 送中に弱まった光信号を光のまま増幅することができる デバイスとして、従来の再生増幅中継器が必要としてた 光/電気あるいは電気/光の変換が不要になるばかりで なく、現在、盛んに研究開発が進められている波長多重 通信(WDM)への適用においては、多数の信号波長を 一括増幅することが可能であることから、従来の通信シ ステムに較べ大幅なシステムの高度化、低コスト化を図 ることが可能となる。

【0003】ここで、光ファイバ通信の重要な波長帯で ある1.5µm帯においては、現在、希土類イオンとし てエルビウム (Er) をコアに添加した石英系光ファイ バを増幅媒体とする光ファイバ増幅器 (EDFA) がす でに実用段階にある。

【0004】しかしながら、もう一つの重要な波長帯で ある1.3 μm帯においては、希土類イオンとしてプラ セオジム (Pr) をコアに添加したフッ化物光ファイバ を増幅媒体とする光ファイバ増幅器(PDFA)が開発 段階にあるが、EDFAに較べその実用化が遅れてい る。これは、Pr中の1.3 μm発光の量子効率が低い ために、光増幅用ファイバとしてフッ化物光ファイバな どのような低いフォノンエネルギーを持つ光ファイバを 用いなくてはならないこと、また、励起光源として高出 カのレーザを必要とする等の理由により、EDFAに較 が0~15モル%であり、かつこれら粗成量の合計が1 50 べてモジュールの小型化、および低価格化が進んでいな

いことによるものである。

【0005】本発明者らは、この低い量子効率を改善す ることを目指し、フッ化物ガラスとして従来用いられて きたZrF4 系フッ化物ガラスに替わる新たなホストガ ラスとして、PbF2 /InF3 系フッ化物ガラス (特 願平9-15744号)を新たに開発することに成功し た。

【0006】このPbF2 / InF3 系フッ化物ガラス は、従来のZrF4系フッ化物ガラスよりも低いフォノ ンエネルギーを有しており、従ってPrの1.3 µm発 10 光の量子効率の改善を期待することができる。実際に、 本発明者らは、該光ファイバを用いたPDFAにおい て、従来のZrF4 系フッ化物光ファイバを増幅媒体と するPDFAの2倍の効率を達成することに成功した。 【0007】しかしながら、この1.3 um帯光ファイ バ増幅器PDFAが増幅できる波長帯域は、ZrF4系 フッ化物光ファイバを用いた場合においては80 nm程 度、PbF2 / InF3 系フッ化物光ファイバを用いた 場合においても90nm程度の増幅帯域(3dBダウ ン)に限られており、WDM通信方式の適用によるさら 20 なる大容量化を目指すためには増幅帯域の広帯域化が望 まれていた。

【0008】また、これとは別に、ZrF4 系あるいは PbF2 / InF3 系フッ化物光ファイバにおいてはP rの 3H4 準位から 3F4 準位への大きな基底状態吸収 (GSA)が波長1.5μmを中心に存在するため、該 GSAのすそが1.3μm発光の長波長側と重なり、 1.32 μmより長波長域での雑音指数が劣化するとい う問題があった。

[0009]

【発明が解決しようとする課題】本発明の課題は、上記 欠点を解決した、低雑音で広帯域な光ファイバ増幅器を 提供することにある。

[0010]

【課題を解決するための手段】前記課題を解決するため に、本発明の請求項1の光ファイバ増幅器は、希土類イ オンが添加された複数の光増幅用ファイバが直列または 並列に接続された構成を有する光ファイバ増幅器であっ て、前記光増幅用ファイバが、フッ化物光ファイバ、テ ルライトファイバ、カルコゲナイドファイド、石英系フ 40 きる。 ァイバのいずれかからなることを特徴とする。

【0011】さらに、本発明の請求項2の光ファイバ増 幅器は、希土類イオンが添加された第1の光増幅用ファ イバと第2の光増幅用ファイバとがアイソレータを介し て直列に接続され、前記第1の光増幅用ファイバは信号 光の進行方向に対して前記アイソレータの前段に位置す るとともに、前記第2の光増幅用ファイバは前記アイソ レータの後段に位置し、前記第1の光増幅用ファイバは カルコゲナイドファイバあるいはテルライトファイバか ァイバからなることを特徴とする。

【0012】前記各光ファイバ増幅器において、それぞ れ、添加される希土類イオンとしては、Pr, Dy, N dを用いることができる。

【0013】同様に、前記各光ファイバ増幅器におい て、フッ化物光ファイバのガラス組成は、原子モル分率 で、InF3 が10~30モル%、GaF3 が7~30 モル%、ZnF2 が10~19モル%、BaF2 が4~ 30モル%、SrF2 が0~24モル%、PbF2 が0 $\sim 30 \pm N\%$, LaF₃, YF₃, GdF₃, LuF₃ よりなる群から選ばれた少なくとも一種が1.5~10 モル%、LiFが1.5~30モル%、NaFが0~3 0モル%、追加成分が0~15モル%であり、かつこれ らの組成量の合計が100モル%となっていても良い。 【0014】ここで、前記追加成分としては、モル%で 表して、BeF2 を0~10、MgF2 を0~10、C aF2 &0~10, CdF2 &0~4, T1F4 &0~ 5、MnF2 &0~5、SmF3 &0~5、ScF3 & 0~5、HfF4 &0~5、ZrF4 &0~5、KF& 0~10, RbF&0~10, CsF&0~10, Bi F3 を0~5、A1F3 を0~15からなる群の少なく とも一種を含有させることができる。

【0015】また、同様に、前記各光ファイバ増幅器に おいて、フッ化物光ファイバのガラス組成は、原子モル 分率で、InF3 が5~25モル%、GaF3 が13~ 40モル%、ZnF2 が4~25モル%、PbF2 が3 0~46モル%、CdF2 が0~20モル%、LaF 3 , YF3 , GDF3 , LuF3 よりなる群から選ばれ た少なくとも一種が1.5~12モル%、追加成分が0 30 ~15モル%であり、かつこれらの組成量の合計が10 0モル%となっていてもよい。

【0016】ここで、前記追加成分としては、モル%で 表して、BeF2 を0~10、MgF2 を0~10、C aF₂ &0~10, BaF₂ &0~15, SrF₂ &0 ~15, T1F4 &0~5, MnF2 &0~5, SmF 3 &0~5, ScF3 &0~5, HfF4 &0~5, Z rF4 &0~5 KF &0~10 RbF &0~10 CsFを0~10、BiF3 を0~5、A1F3 を0~ 15からなる群の少なくとも一種を含有させることがで

【0017】また、同様に、前記各光ファイバ増幅器に おいて、フッ化物光ファイバのガラス組成は、ZrF4 とHfF4 からなる群から選ばれた少なくとも一種が4 3~60モル%、BaF2 が6~28モル%、LaF3 が1.5~6モル%、ScF3, YF3, GdF3, L uF3 からなる群から選ばれた少なくとも一種が1.5 ~6モル%、A1F3 が1.5~6モル%、PbF2 が 0~25モル%、LiFおよびNaFから得らればれた 少なくとも一種が3~25モル%、追加成分が0~15 らなり、前記第2の光増幅用光ファイバはフッ化物光フ 50 モル%であり、かつこれら組成量の合計が100モル%

となっていてもよい。

【0018】ここで、前記追加成分としては、モル%で 表して、BeF2 を0~10、MgF2 を0~10、C aF2 &0~10 SrF2 &0~15 CdF2 &0 ~4 T1F4 &0~5 MnF2 &0~5 SmF3 £0~5, ScF₃ €0~5, KF €0~10, RbF \$60~10, CsF\$60~10, InF3 \$60~5, G aF3 を0~5、BiF3 を0~5からなる群の少なく とも一種を含有させることができる。

【0019】また、同様に、前記各光ファイバ増幅器に 10 おいて、テルライトファイバのガラス組成は、TeO2 が55~90モル%、ZnO, WO3, Li2 O, Na 2 O, A 12 O₃ , B i 2 O₃ からなる群から選ばれた 少なくとも二種がそれぞれ0~35モル%であり、かつ これら組成量の合計が100モル%となっていてもよ

【0020】さらに、同様に、前記各光ファイバ増幅器 において、カルコゲナイドファイバのガラス組成が、カ チオンとしてGa, Ge, In, La, Na, Li, K, Csからなる群から選ばれた少なくとも一種を含有 20 し、アニオンとしてS, C1, I, Brからなる群から 選ばれた少なくとも一種を含有したものであってもよ 11

[0021]

【発明の実施の形態】希土類イオンの発光スペクトル は、希土類イオンが添加されたホストガラスの種類によ ってそれぞれ異なった形を持っている。これは、スペク トルの形を決定するエネルギーレベルの分裂(シュタル ク分裂)の様子が、配位子場の影響でそれぞれのホスト ガラスについて異なっているためである。

【0022】発明者らは、Prの1.3 μm発光のスペ クトル形状について鋭意検討した結果、図1に示したよ うに、カルコゲナイドガラスおよびテルライトガラス中 の1. 3μm発光スペクトルが、ZrFi 系あるいはP bF2 / InF3 系フッ化物ガラス中において見られる スペクトルよりも長波長側にずれていることを見い出し た。ここで、図1の横軸は波長を、縦軸は得られたそれ ぞれのガラスの1.3 μm発光の強度を1に規格化して 示してある。

ルライトガラス中においては、3H4 準位から3F4 準 位への規定状態吸収(GSA)の中心もZrF4系ある いはPbF2 / InF3 系フッ化物ガラス中で見られた ものよりも長波長側にずれているために、ZrF4 系あ るいはPbF2 / InF3 系フッ化物ガラスの光増幅時 に問題となっていた1.32μmよりも長波長側での雑 音指数の劣化も見られないことを、本発明者らは見い出 した。

【0024】一方、低雑音、高出力を得るための光ファ

の中間にアイソレータを配置したカスケード接続による EDFAの報告例がある(山下他、"Improvement of e rbium-doped fiber amplifier characteristics by ins ertion of midway-isolator ", In Proc. OEC'92, 17B 3-3, 1992)。このEDFAにおいては、前段の980 n m励起のEDFAより得られた低雑音で高利得の信号を アイソレータを介して後段の1480nm励起のEDF Aに入力することによって、低雑音、高出力の光増幅を 実現している。

【0025】これは、前述したカスケード接続の光ファ イバ増幅器で得られる雑音指数の値が、

[0026]

【数1】全体の雑音指数 (NF) =前段のNF+ (後段 のNF)/(前段の利得)

で与えられるため、前段部において高い利得を達成する と、後段部における雑音指数の劣化が緩和されること、 また、励起光から信号光へのエネルギー変換効率が励起 光と信号光 (1550 nm) の波長が近接しているほど 高いために、EDFAにおいては980nm励起よりも 1480 n m 励起による方が高出力特性に優れているこ とを、利用している。

【0027】従って、前述したEDFAにおいては、前 段部において980nm励起による低雑音でかつ高利得 の増幅特性を実現し、後段部において1480nm励起 による雑音特性の劣化を前段部での高利得によって緩和 して、高出力化を行っている。

【0028】本発明者らは、低雑音で高利得、広帯域の 1. 3 μm帯用の光ファイバ増幅器の構成を鋭意検討し た結果、前段に前述した波長1.34μm近傍に利得の 30 ピークを持つPr添加カルコゲナイドファイバあるいは テルライトファイバを配置し、アイソレータを介した後 段に波長1.30 μmに利得のピークを持つPr添加の PbF2 / InF3 系ファイバあるいはZrF4 系ファ イバを配置することによって、低雑音でかつ高利得、広 帯域な光ファイバ増幅器が構成できることを、見い出し

【0029】本構成によると、前段部と後段部に利得の ピーク位置の異なる光増幅ファイバを配置することによ って、正味の増幅帯域が広がるとともに、PbF2/I 【0023】また、カルコゲナイドガラスあるいは、テ 40 nF3 系、あるいは2rF4 系フッ化物光ファイバを用 いたときに問題となっていた、前述したGSAの影響に よる波長1.32μmよりも長波長側での雑音指数の劣 化を、前段部においてカルコゲナイド、あるいはテルラ イトファイバを用いて得られる1.32μmよりも長波 長域での高利得によって、緩和することが可能となり、 正味の増幅帯域全域にわたって低雑音特性が実現される ものである。

【0030】ここで、広帯域の光ファイバ増幅器を実現 するためには、テルライトあるいはカルコゲナイドファ イバ増幅器の構成法として、2本の光増幅用光ファイバ 50 イバと、PbF2 /InF3 系あるいはZrF4 系フッ

化物光ファイバとのどちらかの群が、前段あるいは後段に配置される構成となっても良い。しかしながら、広帯域でかつ、低雑音の光増幅を実現するためには、前段にテルライトあるいはカルコゲナイドファイバを、また、後段にPbF2 / InF3 系、あるいはZrF4 系フッ化物光ファイバを配置することが、前述した1.32μmより長波長での雑音指数の劣化を緩和する意味で好適である。また、テルライトあるいはカルコゲナイドファイバと、PbF2 / InF3 系あるいはZrF4 系フッ化物光ファイバとを、フィルタあるいはWDMファイバカップラを介して並列に配置する構成によっても、広帯域な光ファイバ増幅器を構成できる。

【0031】本発明による光ファイバ増幅器の構成は、前述したEDFAのカスケード接続による低雑音、高出力用光ファイバ増幅器の構成とは、前段、後段に異種のファイバを用いている点が異なる。また、用いている前段、後段の光増幅用光ファイバが有する増幅帯域が異なっており、これらの異なった増幅帯域を重ね合わせることによって、光ファイバ増幅器の正味の増幅帯域を拡大している点が異なる。さらに、本発明は、1.3μm帯 20の増幅帯域を低雑音特性を維持して拡大するためになされたものであり、前述した1.5μm帯での低雑音、高出力特性を実現するための構成とは、本質的に適用される波長帯が異なることを、明記しておく。

【0032】さらに、本発明者らは、本発明の光ファイバ増幅器を実現するためのPbF2/InF3系フッ化物光ファイバのガラス組成について検討を行った結果、原子モル分率でInF3を10~30モル%、GaF3を7~30モル%、ZnF2を10~19モル%、BaF2を4~30モル%、SrF2を0~24モル%、P30bF2を0~30モル%、LaF3, YF3, GdF3, LuF3よりなる群から選ばれた少なくとも一種を1.5~10モル%、LiFを1.5~30モル%、NaFを0~30モル%、過加成分を0~15モル%とし、かつその合計が100モル%よりなる組成域において安定なガラスが得られることを、見い出した。

【0033】ここで、InF3, GaF3は、ガラスの 骨格をなす必須成分である。InF3は、10~30モル%含有することが望ましく、10モル%以下、あるいは30モル%以上においては結晶化によって透明なガラ40スを得ることはできない。また、GaF3は、7~30モル%の範囲で含有することが望ましく、7モル%以下、あるいは30モル%以上においては結晶化によって 安定なガラスが得られない。

【0034】 ZnF2 , BaF2 は、ガラス骨格を修飾するための必須成分である。ここで、ZnF2 は10~19モル%の範囲で含有することが望ましく、10モル%以下、あるいは19モル%以上においては結晶化の傾向が顕著となるために安定なガラスを得ることができない。BaF2 は、4~30モル%含有することが望まし

く、4モル%以下、あるいは30モル%以上においては 結晶化によって安定なガラスを得ることができない。

【0035】SrF2 は、0~24モル%の範囲でBaF2 に置き換わることが可能であり、ガラスの熱安定性を増加させる働きを有する。

【0036】PbF2, NaFは、ガラスの熱安定性を改善するための成分である。これらの成分を含有することによって、均一なガラス融液が低温においても得られるようになり、ガラス形成能を増加させることが可能である。ここで、PbF2は、0~30モル%の範囲で含有することが望ましく、30モル%以上においてはガラス融液の揮発性が増加し、安定なガラスを得ることが塑しい。NaFは、0~30モル%含有することが望ましく、30モル%以上においては結晶化が顕著となって安定なガラスが得られない。

【0037】LiFは、ガラスを安定化させるのに特に 重要な成分であり、1.5~10モル%の範囲で含有す ることが特に望ましい。さらに、PbFz を含有した系 において安定なガラスを得るためには、LiFを含有す ることが必須の条件となる。

[0038] LaF3, YF3, GdF3, LuF3 は、ガラスの熱安定性を増加させるための必須の成分で ある。この時、これらのうち少なくとも1種を、1.5 ~10モル%含有することが望ましく、1.5モル%以 下の含有量においては熱安定性を増加を確認することは できず、また10モル%以上の含有量においては結晶化 の傾向が顕著となって安定なガラスが得られなくなる。 【0039】また、本発明者らは、本発明の光ファイバ 増幅器を構成するPbF2 / InF3 系フッ化物光ファ イバの別の実施態様について検討した結果、原子モル分 率で、InF3 を5~25モル%、GaF3 を13~4 0モル%、ZnF2 を4~25モル%、PbF2 を30 ~46モル%、CdF2 を0~20モル%、LaF3、 あるいはYF3 , GdF3 , LuF3 よりなる群から選 ばれた少なくとも一種を1.5~12モル%、追加成分 を0~15モル%とし、かつその合計が100モル%よ りなる組成域において安定なガラスが得られることを見 い出した。

【0040】ここで、InF3 およびGaF3 は、ガラスの骨格をなす必須成分である。この時、InF3 は5~25モル%含有することが望ましく、5モル%以下においては透明なガラスを得ることは不可能である。また、25モル%以上においても結晶化の傾向が顕著となり良好なガラスを得ることができない。GaF3 は、13~40モル%含有することが望ましく、13モル%以下においては結晶化によって透明なガラスを得ることが難しく、40モル%以上においてはガラス融液が黄濁し透明なガラスは得られない。

向が顕著となるために安定なガラスを得ることができな 【0041】PbF2,ZnF2 は、ガラス骨格を修飾い。BaF2 は、 $4\sim30$ モル%含有することが望まし 50 するための必須成分である。これらのイオンが含有され

ス中に結晶が析出するので、不適である。また、少なく 含有された場合においては、熱安定性を高める効果を確 認することができない。

ることによって、均一な融液が低温でも得られるように なり、ガラス形成能が増加する。ここで、PbF2 は、 30~46モル%含有することが望ましく、30モル以 下においては結晶化によって透明なガラスを得ることが 難しく、また、46モル%以上においてはガラス融液が 揮発しやすくなり、安定なガラスが得られない。また、 ZnF2 は、4~25モル%含有することが望ましく、 4モル%以下においては結晶化によって透明なガラスは 得られず、25モル%以上においても結晶化の傾向が顕 著となり、透明なガラスは得られない。また、CdF2 は、0~20モルの範囲でPbF2 あるいはZnF2 に 置き換わって含有されることが可能である。好ましく は、0~7モルの範囲で含有されることによって、ガラ ス形成能を増加させ、安定なガラスを得るのに有効であ る。さらに、LaF3 あるいはYF3, GdF3, Lu F3 は、本発明のフッ化物ガラスにおいて、結晶化に対 する熱安定性を改善するための必須成分である。これら のうち少なくとも一種を1.5~12モル%含有するこ とによって、再加熱に対する熱安定性を向上させること が可能である。

【0044】PbF2 は、BaF2 に置き換わって含有 されることによってガラスの屈折率を大きくする働きを 有する。前述した範囲を超えて含有された場合において は、ガラス中に結晶が析出するので、不適である。

【0045】さらに、本発明者らは、本発明の光ファイ

バ増幅器を構成するテルライトファイバのガラス組成に

nO, WO3, Li2O, Na2O, Al2O3, La

2 O3 , Bi2 O3 からなる群から選ばれた少なくとも

二種をそれぞれ0~35モル%含有し、かつその合計が

100モル%よりなる組成域において、安定なガラスを

10 ついて検討した結果、TeO2 を55~90モル%、Z

得ることができることを、見い出した。 【0046】ここで、TeO2 は、ガラスの骨格である 網目構造をなす必須の成分であり、55~90モル%の 範囲で含有することが望ましい。55モル%より少ない 領域、あるいは90モル%よりも多い領域においては、 結晶化によって安定なガラスを得ることは難しい。

【0042】さらに、本発明者らは、本発明の光ファイ バ増幅器を構成するZrF4 系フッ化物光ファイバのガ ラス組成について検討を行った結果、ZrF4 とHfF 4 からなる群から選ばれた少なくとも一種を43~60 モル%、BaF2 を6~28モル%、LaF3 を1.5 ~6モル%ScF3, YF3, GdF3, LuF3から なる群から選ばれた少なくとも一種を1.5~6モル %、AIF3 を1.5~6モル%、PbF2 を0~25 モル%、LiFおよびNaFから選ばれた少なくとも一 種を3~25モル%、追加成分を0~15モル%とし、 かつその合計が100モル%よりなる組成域において、 安定なガラスが得られることを、見い出した。

【0047】 また、ZnO, Bi₂O₃, Li₂O, N a2 O, A12 O3, WO3, La2 O3は、網目構造 を修飾するための成分であり、これらのうち少なくとも 2種類を、それぞれ0~35モル%の範囲で含有するこ とが望ましい。35モル%よりも多く含有された場合に おいては、結晶化によってガラスを作製することが難し くなる。

【0043】ここで、ZrF4, HfF4は、ガラスの 骨格である網目構造をなす必須の成分であり、43~6 0モル%の範囲で含有することが望ましい。43モル% より少なく、あるいは60モル%より多く含有された場 合においては、ガラス内部に結晶が析出するので、不適 である。また、BaF2, LaF3, A1F3と、Li F, NaFから選ばれた少なくとも一種と、ScF3, YF3, GdF3, LuF3 から選ばれた少なくとも一 40 種は、ガラスの網目構造を修飾し、ガラスの熱安定性を 高めるための必須の成分であり、それぞれ前述した範囲 において含有されることが望ましい。前述した範囲を外 れたものは、不適である。また、BaF2 , LaF3 , A1F3 と、LiF, NaFから選ばれた少なくとも一 種と、ScF3, YF3, GdF3、LuF3から選ば れた少なくとも一種は、ガラスの網目構造を修飾し、ガ ラスの熱安定性を高めるための必須の成分であり、それ ぞれ前述した範囲において含有されることが望ましい。

【0048】さらに、本発明者らは、本発明の光ファイ バ増幅器を構成するカルコゲナイドファイバのガラス組 成について検討した結果、カチオンとしてGa, Ge, In, La, Na, Li, K, Csからなる群から選ば れた少なくとも一種を含有し、アニオンとしてS,C 1, I, Brからなる群から選ばれた少なくとも一種を 含有する組成域において、安定なガラスを得ることがで きることを、見い出した。

【0049】ここで、Gaz S3 は、ガラスの骨格をな す必須の成分であり、38~75モル%の範囲で含有さ れることが望ましい。Laz Sa, Ge Sz, Inz S 3 は、ガラスの骨格を修飾して耐候性および熱安定性を 高める働きを持っており、0~20モル%の範囲で含有 されることが望ましい。Laz S3 、Inz S3 が20 モル%多く含有された場合には、液相温度が上昇し、G eS2 が20モル%より多く含有された場合は、ガラス 融液が揮発し易くなり、安定なガラス融液の状態を得る ことが難しくなる。また、Na2 S, Li2 S, K2 S, Cs2 S, NaCl, LiCl, KCl, CsC 1, NaI, LiI, KI, CsI, NaBr, LiB r, KBr, CsBrは、ガラスの骨格を修飾してガラ ス形成能を増加させる働きを有するが、55モル%より 前述した範囲より多く含有された場合においては、ガラ 50 多く含有された場合においては、逆にガラス形成能を著 しく劣化させ、安定なガラスを得ることが難しくなる。 [0050]

【実施例】以下、本発明について実施例を詳細に説明す るが、本発明はこれらの実施例によりなんら限定される ものでない。

【0051】(実施例1)本実施例においては、図2に 示したような第1、第2の光増幅用光ファイバの中間に アイソレータを配置した光ファイバ増幅器を構成した。 図中、1は第1の光増幅用ファイバ、2は第2の光増幅 用ファイバ、3はアイソレータ、4はWDMファイバカ 10 ップラ、5は励起光源である。

【0052】本実施例においては、第1の光増幅用ファ イバとしてPェ添加カルコゲナイドファイバを、また、 第2の光増幅用ファイバとしてPァ添加乙ァF4 系フッ 化物光ファイバを用いて光ファイバ増幅器を構成した。 【0053】光増幅用ファイバとして用いたZrF4系 フッ化物光ファイバは、ジャケット延伸法によって作製 した。まず、51ZrF4 - 18BaF2 - 11PbF 2-3.5LaF3-2YF3-4.5A1F3-10 LiFをコアガラス組成とし、49ZrF4-21Ba $F_2 - 3.5 La F_3 - 2 Y F_3 - 4.5 Al F_3 - 2$ ONaFをクラッドガラスとするフッ化物光ファイバ母 材 (外形5mmø、長さ50mm) を、サクションキャ スティング法によって作製した。これとは別に、クラッ ドガラスと同一の組成を有するジャケット管(外形15 mmø、長さ140mm)をローテーションキャスティ ング法を用いて作製した。作製したジャケット管にファ イバ母材を挿入してチャックに保持し、内部を真空排気 しながら320℃に加熱された加熱炉内に上部より毎分 2mmの速度で挿入し、125 μmの光ファイバを製造 30 した。製造されたZrF4系フッ化物光ファイバは単一 モードであり、比屈折率差3.7%、コア径1.8 µ m、カットオフ波長1.0μmであり、Pr添加濃度は 1000ppm、損失値は波長1.2μmで、0.04 dB/mであった。

【0054】一方、カルコゲナイドファイバは、ロッド インチューブ法によって作製した。まず、65Ga2 S 3 -14La₂ S₃ -21Na₂ Sからなる組成のコア ガラスバッチを、グラッシーカーボンるつば内で溶融 し、ステンレス製の鋳型にキャスティングすることによ 40 ことができた。 り、コア母材 (外径5mmø、長さ140mm)を作製 した。これとは別に50Ga2 S3 - 15Ge2 S3 -

14La₂ S₃ -21Na₂ Sからなる組成のジャケッ ト管 (内径5mmø、外径15mmø、長さ140m m)を作製し、先に作製したコア母材の表面を光学研磨 した後、ジャケット管に挿入した。ジャケット管を真空 チャックに保持した後、内部を真空排気し、450℃に 加熱された加熱炉内に上部から毎分2mmの速度で送り 込み、ジャケット管の下部を別のチャックによって保持 して下方に毎分30mmの速度で下降させることによ り、外径5mmø、コア径50μmの延伸母材を作製 し、該延伸母材を再度ジャケット管に挿入し、480℃ に加熱された線引き炉内に毎分3mmの送り速度でジャ ケット管を送り込み、外径125μmのファイバを作製 した。製造された光ファイバは、Δn=1.5%、コア 径2. 2μ m、カットオフ波長1. 0μ mの単一モード ファイバであり、Prの添加濃度は1000ppm、損 失は波長1.2μmにおいて1dB/mであった。 【0055】図3に、本実施例の光ファイバ増幅器の入 射信号光量-30dBmに対する信号利得スペクトルを 示す。励起光源としては発振波長1.017 µmのLD を用い、前段のカルコゲナイドファイバの励起光量は1 00mW、後段のZrF4 系ファイバの励起光量は25 OmWとした。図中、左縦軸は信号利得の値を示し、ま た横軸は信号波長を示している。用いた2 r F4 系の光 増幅用ファイバは20mであり、また、カルコゲナイド ファイバは8mである。図3には、従来のZrF4系フ ッ化物光ファイバの利得スペクトル(点線)、カルコゲ ナイドファイバの利得スペクトル (一点鎖線) も比較の ために示してある。図から、波長1.29から1.35 μmにわたって20dB以上利得が得られ、従来のスペ クトルに対し、増幅帯域が拡大されていることが分か る。また、図3の右縦軸には雑音指数を示した。雑音指 数は、測定された波長領域にわたって、5dBの低雑音 が実現されており、前述したZrF4系フッ化物光ファ イバを用いたときに見られた波長1.32入mより長波 長域での雑音指数の劣化は、見られないことがわかる。 【0056】この他、表1から表5に示したコアガラス 組成を有するカルコゲナイドファイバ、あるいは表6に 示したコアガラス組成を有する ZrF4 系フッ化物光フ ァイバを用いた場合においても、同様の増幅特性を得る

[0057]

【表1】

			`	O ,				•
13							1	4
Ga_2S_3	GeS ₂	In ₂ S ₃	La ₂ S ₃	CS ₂ S	CsCl	Cal	CsBr]
66				34]
55				45				1
75				25				1
45				55				1
70				30				1
70				25	5			1.
66				25	9			1
55				25	20			1
65				25		10		1
65				25			10	À
57			9	22	12			1
50			16	22	12			1
63			3	22	12			1
55			11	28	6			1
50			20	30]
. 70			14	16				1
65			10	· ·	25			1
65			10			25		1
65			10				25	3
64		6	14	16				1
58		12	14	16				1
52		18	14	16				1
60		6	6	16	12			1
60		6	6	16		12		1
60		6	6	16			12	1
54	10	6	14	16				1
48	10	12	14	16				1
38	20	12	14	16				1
48	· 10	12		6		10		1
48	10	12	14	6			10	1

[0058]

* *【表2】

15

Ga ₂ S ₃	GeS ₂	In ₂ S ₃	La ₂ S ₃	Na ₂ S	NaCl	NaI	NaBr
66				34			
55				45			
75				25			
45				55			
70				30			
70				25	5		
66				25	9		
55				25	20		
65			-	25		10	
65				25			10
57			9	22	12		
50			16	22	12		
63			3	22	12		
55			11	28	6		
50			20	30			
70			14	16			
65			10		25		
65			10			25	
65			10				25
64	l	6	14	16			
58		12	14	16			
52		18	14	16			
60		6	6	16			
60		6	6			12	
60		6	6	16			12
54			14	16			
48			14			L	
38	_		14				
48			14			10	
48	10	12	14	6			10

[0059]

* *【表3】

Ga ₂ S ₃	GeS ₂	In ₂ S ₃	La ₂ S ₃	Na ₂ S	CeCI	Cs[CsBr
70				25	5		
66				25	9		
55				25	20		
65				25		10	
65				25			10
57			9	22			
50	i		16	22	12		
63			3	22	12		
55			11	28	6		
65			10		25		
65			10	_		25	
65			10				25
60		6	6	16	12		
60	<u> </u>	6	6	16		12	
60		6	6	16			12
48	10	12	14	6		10	
48	10	-12	14	6			10

[0060]

※ ※【表4】

_	_
1	-7
- 1	•

			•					
17								18
Ga_2S_3	GeS ₂	In ₂ S ₃	La ₂ S ₃	Na ₂ S	KCI	KI	KBr	
70				25	5			
66				25	9			
55				25	20			
65				25		10		_
65			·	25				10
57			9	22	12			_
50			16	22	12			_
63			3	22	12			
55			11	28	6			
65			10		25			_
65			10			25		_
65			10				<u> </u>	25
60		6	6	16	12			
60		6	6	16		12		7
60		6	6	16				12
48	10	12	14	6		10	· · · · ·	7
48	10	12	14	6		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		10

[0061]

* *【表5】

Ga ₂ S ₃	GeS ₂	In ₂ S ₃	La ₂ S ₃	Na ₂ S	LICI	LÍT	LiBr
70				25	5		
66				25	9		
55				25	20		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
65				25		10	
65				25			10
57			9	22	12		
50			16		12		
63			3	22	12	_	
55			11	28	6		
65			10		25		
65			10			25	
65			10				25
60		6	6	16	12		
60		6	6	16		12	
60		6	6	16		 '-	12
48	10	12	14	6		10	<u>'</u> -
48	10	12	14	6		19	10

[0062]

※ ※【表6】

1	9										2	0
ZrF4	H#F4	BaF ₂	PbF ₂	BeF ₂	LaFa	ScF ₃	YFa	GdF ₃	LuF3	AIF3	LiF	NaF
52		27		1								21
52		20			4.5							23.5
52		13	11		2.5							21.5
47.5		23.5			2.5		2			4.5	10	10
47.5		23.5			2.5		2			4.5		20
	47.5	23.5			2.5		2			4.5		20
	43	28		1	2.5		4			2.5		20
43		28		1	2.5	4				2.5		20
43		28			2.5				4	2.5		20
55		18.5			4		2		-	2.5		18
	52.5	18			3		5			4.5		20
	55	18			2.5		2			4.5		18
	52.5	23.5			2.5		2			4.5		15
43		26			3.5		2			2.5		23
48		25			1.5		1.5			5	19	
48		25			1.5	1.5				5	19	
48		25			1.5			1.5		5	19	
48		25		1	1.5				1.5	5	19	
	48.5	23.5			4		0			5	. 19	
	46.5	23.5			6		2.5			1.5		20
	46.5	22.5		 	1.5		4	1.	ļ	4.5		2
50		20	10		3.5		2	1		4.5	10	
50		20	10	ı	6					4	10	
50		19	15		2		2			2	10	
50		19	15		2		2			2		10
50	1	19	15	1	2	1	2			2	5	
60		6			6		1.5		1	1.5	Э	
60		6	22	2	6					1.5		
60		13	15	i	3		i	1.5	3	1.5		
60		17	7	1	4		3			5		
60		17	7		4		3			5		
60	1	17	7	1	4		3			5	4	
56		. 17	7	1	3				<u> </u>	5		1:

【0063】(比較例1)実施例1と同様の構成の光フ ァイバ増幅器を構成した。ただし、本比較例において は、第1、第2の光増幅用ファイバは、共にZrF4系 フッ化物光ファイバを用いた。図4に、本比較例の光フ ァイバ増幅器によって得られた利得スペクトルを示す。 入射信号光量は-30dBmとし、励起波長は1.01 30 7μm、励起光量は前段および後段ともに300mWと した。図中、左縦軸は信号利得を表し、また横軸は信号 波長を表す。3dBダウンの増幅帯域は、1.29~ 1. 31μmまでの20nmであり、実施例1の構成よ りも狭いことが分かる。また、図中、右縦軸に示した雑 音指数も1.33 µmよりも長波長域において上昇して いることが分かる。以上より、実施例1の構成の光ファ イバ増幅器が、広帯域特性、雑音特性に優れていること が分かる。

1の光ファイバ増幅器の構成において、第1の光増幅用 ファイバとして、ZrFi系フッ化物光ファイバを、ま た、第2の光増幅用ファイバとしてカルコゲナイドファ イバを配置した構成を有する光ファイバ増幅器を構成し た。図5に、本比較例の構成により得られた利得スペク トルを示す。入射信号光量は-30dBmであり、励起 波長は1.017μmとした。図は、左縦軸に利得を横 軸に波長を示している。図から波長1.295~1.3 55μmにわたって20dBの利得が得られており、増 *わかる。また、図5の右縦軸には雑音指数を示した。雑 音指数は波長1.32μmよりも長波長側で劣化してお り、本構成による雑音指数の改善が認められないことが わかる。

【0065】 (実施例2) 本実施例においては、実施例 1と同様の構成において、第1の光増幅用ファイバとし てPr添加テルライトファイバを、また、第2の光増幅 用ファイバとしてPr添加PbF2 /InF3 系フッ化 物光ファイバを用いた光ファイバ増幅器を作製した。 【0066】第1の光増幅用ファイバとして用いたテル ライトファイバはジャケット延伸法によって作製した。 まず、70TeO2 -10ZnO2 -5Bi2 O3 -1 ONa2 Oをコアガラス組成とし、70TeO2 -10 ZnO2 -15Na2 Oをクラッドガラスとするフッ化 物光ファイバ母材 (外径5mmφ、長さ50mm) をサ 【0064】(比較例2)本比較例においては、実施例 40 クションキャスティング法によって作製した。これとは 別に、クラッドガラスと同一の組成を有するジャケット 管 (外径15mmø、長さ140mm) をローテーショ ナルキャスティング法を用いて作製した。作製したジャ ケット管にファイバ母材を挿入してチャックに保持し、 内部を真空排気しながら350℃に加熱された加熱炉内 に上部より毎分2mmの速度で挿入し、別のチャックで 保持されたジャケット管下部を毎分30mmの速度で下 部に延伸することによって、コア径が細径化された第2 のファイバ母材を得た。得られた第2のファイバ母材を 幅帯域が従来のスペクトルに較べ拡大されていることが *50 別に用意したジャケット管(70TeOz-10ZnO

2-15Na2 O、外径15mmø、長さ140mm) に挿入し、ジャケット管上部をチャックで保持して内部 を真空排気しながら、380℃に加熱された線引き炉中 に毎分3mmの速度で挿入し、線引きすることによって 外径125μmの光ファイバを製造した。製造されたテ ルライトファイバは単一モードであり、比屈折率差1. 5%、コア径2. 2 µm、カットオフ波長1. 0 µmで あり、Pr添加濃度は1000ppm、損失値は波長 1. $2\mu m \mathcal{C}$, 0. $06 dB/m \mathcal{C}$ δ δ δ

いたPbF2 / InF3 系フッ化物光ファイバも同様の ジャケット延伸法によって作製した。25.5 In F3 -11.5GaF3 -15ZnF2 -18PbF2 -12BaF2 -8SrF2 -2. 5YF3 -2. 5LaF 3 -5LiFをコアガラス組成とし、25.5InF3 -11.5GaF3 -14ZnF2 -2.5PbF2 -19BaF₂ -8SrF₂ -2. 5YF₃ -2. 5La $F_3 - 7.5$ NaF-7LiFをクラッドガラスとする フッ化物光ファイバ母材 (外径5mmφ、長さ50m m)をサクションキャスティング法によって作製した。 これとは別に、ジャケット管(492rF4-21Ba $F_2 = 3.5 LaF_3 = 2YF_3 = 4.5A1F_3 = 2$ ONaF、外径15mmø、長さ140mm) をローテ ーショナルキャスティング法を用いて作製した。作製し たジャケット管にファイバ母材を挿入してチャックに保 持し、内部を真空排気しながら320℃に加熱された加 熱炉内に上部より毎分2mmの速度で挿入し、別のチャ ックで保持されたジャケット管下部を毎分30mmの速 度で下部に延伸することによって、コア径が細径化され た第2のファイバ母材を得た。得られた第2のファイバ 30 母材を別に用意したジャケット管 (外径12mmø、長 さ140mm) に挿入し、ジャケット管上部をチャック で保持して内部を真空排気しながら、350℃に加熱さ れた線引き炉中に毎分3mmの速度で挿入し、線引きす ることによって外径125μmの光ファイバを製造し た。製造されたPbF2/InF3系フッ化物光ファイ バは単一モードであり、比屈折率差3.7%、コア径 1. 8 μm、カットオフ波長1. 0 μmであり、Pr添

加濃度は1000ppm、損失値は波長1.2μmで、 0.04dB/mであった。

【0068】図6に、本実施例の光ファイバ増幅器の入 射信号光量-30dBmに対する信号利得スペクトルを 示す。励起光源としては発振波長1.017 µmのLD を用い、前段のテルライトファイバの励起光量は300 mW、後段のPbF2 /InF3 系フッ化物光ファイバ の励起光量は200mWとした。図中、左縦軸は信号利 得の値を示し、また、横軸は信号波長を示している。用 【0067】一方、第2の光増幅用光ファイバとして用 10 いたPbFz /InFa 系の光増幅用ファイバは15m であり、また、テルライトファイバは5mである。図6 には、従来のPbF2 /InF3 系フッ化物光ファイバ の利得スペクトル(点線)、テルライトファイバの利得 スペクトル(一点鎖線)も比較のために示してある。図 から、波長1.285から1.345μmにわたって2 0dB以上利得が得られ、従来のスペクトルに対し、増 幅帯域が拡大されていることが分かる。また、図6の右 縦軸には雑音指数を示した。雑音指数は測定された波長 領域にわたって、5dBの低雑音が実現されており、前 20 述したPbF2 / InF3系フッ化物光ファイバを用い たときに見られた波長1.32μmより長波長域での雑 音指数の劣化を見られないことがわかる。この他、表7 から表9に示したコアガラス組成を有するテルライトフ ァイバ、あるいは、表10、表11に示したコアガラス 組成を有するPbF2 /InF3 系フッ化物光ファイバ を用いた場合においても、同様の増幅特性を得ることが できた。

> 【0069】この他、第2の光増幅用ファイバとして実 施例1で用いた2rF4 系フッ化物光ファイバを用いた 場合 (テルライトファイバ+ZrF4 系ファイバ)、あ るいは、第1の光増幅用ファイバとして実施例1で用い たカルコゲナイドファイバを用いた場合(カルコゲナイ ドファイバ+PbF2 /InF3 系ファイバ) において も、同様に低雑音かつ増幅帯域が拡大した光ファイバ増 幅器を構成することができた。

[0070]

【表7】

				(1)	,			130
2:								24
No.	TeO ₂	Bi ₂ O ₃	ZnO	Na ₂ O	Li ₂ O	Al ₂ O ₃	WO ₃	La ₂ O ₃
1	55	5	5	35				
2	55		15	25				
3	55		30	10				
4	70	5		25				
5	70	5	5	20				
6	70	5	20	5				
7	80	5		15				
8	80	5	5	10				
9	80	5	15					
10	90	5	2.5	2.5				
11	60		10	30				
12	70			30				
13	70		15	15				
14_	70		30				T	
15	80			20				
16	80		10	10				
17	55	5	5		35			
18	55		35		5			
19	70	5			25			
20	70		5		20			· ·
21	70		15		10			
22	70	5	25					
23_	60		10		30			
24	60		20		20			
25	70				30			
26	70		15		15			
27	80				20			
28	80		10		10			
29	55			35			10	
30	60			30			10	

[0071]

* *【表8】

No	TeO ₂	Bi ₂ O ₃	ZnO	Na ₂ O	Li ₂ O	Al ₂ O ₃		La ₂ O ₃
31	60		,	20			20	
32	70			30				
33	70			15			15	
34	70						30	
35	70	5		25				
36	70	5		15			10	
37	70			5			20	
38	70	5					25	
39	80			20				
40	80	-		10			10	
41	90			5			5	
42	55				35		10	
43	60				30		10	
44	60				20		20	
45	70	5			15		10	
46	70	5			5		20	
47	80				20		L	
48	80				10		10	
49	90				5		5	<u> </u>
50	55			35		10		
51	70			30				L
52	70			15		15		
53	70					30		
54	70			25				
55	70			15		10		
56	80			20				

2.0	=							26
2 !				-			 .	26
No	TeO ₂	Bi ₂ O ₃	ΖτΟ		Li ₂ O	Al ₂ O ₃	WO ₃	La ₂ O ₃
57	80			10		10		
58	90			5		5		
_59	70				15	15		
60	70	5			25			
61	70	5			15	10		
62	70	. 5			5	20		
63	80				20			
64	. 80				10	10		
65	90				5	5		
66	55			35				10
67	60			. 30				10
68	70			15				15
69	70							30
70	70	5		25				—— <u>—</u>
71	70	5		15				10
72	80			20			-	— <u> </u>
73	80			10			-	10
74	90			5				5
75	55				35			10
76	70				15			15
77	70	5			25			
78	70	5 5		†	15			10
79	70	5			5			20
80	80				20			
81	80				10			10
82	90				5			5

[0073]

* *【表10】

InF;	GaF	ZnF	PbF,	BeF:	SrF ₂	CdF ₂	MgF ₂	AIFa	YF ₂	LaF ₃	lGdF:	LuF) L BE	NaF
13.0	40.0	12.0	20.0	5.0		-			2.5	2.5			5.0	
	35.0								2.5	2.5	 	 	5.0	_
12.0	31.0	12.0	25.0	5.0	5.0				2.5	25	_	_	5.0	_
	29.0		33.0	5.0					4.0	4.0	\vdash		3.0	├─
13.0	29.0	5.0	38.0	4.0					11.0		_	 	-	
	29.0		34.0	4.0			_		15.0		_		-	
13.0	29.0	5.0	34.0	4.0			_			15.0		-	\vdash	<u> </u>
	29.0		38.0	4.0					4.0	4.0		_	—	\vdash
13.0	24.0	8.0	43.0	4.0					4.0	4.0		\vdash	\vdash	_
	24.0		48.0		4.0				4.0		\vdash		\vdash	
	24.0		50.0		4.0				4.0					
	27.0		25.0	9.0	4.0	$\neg \neg$			2.5	2.5	-		5.0	
	25.0		25.0		4.0				2.5	2.5			5.0	
15.0	22.0	15.0	25.0	9.0	4.0				2.5	2.5			5.0	
18.5	18.5	15.0	25.0	9.0	4.0				2.5	2.5			5.0	_
18.5	18.5	15.0	25.0	9.0	4.0		_	一十	25	2.5			J.V	5.0
18.5	18.5	15.0	25.0	9.0	4.0				25		2.5		5.0	3.0
18.5	18.5	15.0	25.0	9.0	4.0		-1		2.5			2.5	5.0	
18.5	18.5	15.0	20.0	14.0	4.0		_	-	25	2.5		2.5	5.0	
18.5	18.5	13.0	20.0	16.0	4.0				25	2.5			5.0	-- $+$
18.5	18.5	15.0	15.0	19.0	4.0		\neg	-+	2.5	2.5	-		_	
18.5	18.5	15.0	10.0	20.0	8.0		\neg		2.5	2.5		\dashv	5.0 5.0	
18.5	18.5	15.0	10.0	20.0	8.0	\neg	\neg	- +	2.5	2.5			5.0	ᇎ
20.0	17.0	15.0	25.0	9.0	4.0				2.5	25		-	E 0	5.0
	15.5			9.0	4.0		\neg		25	2.5			5.0	
	14.0			9.0	4.0	\dashv		+	25	2.5			5.0	
					v				2.5	∠. D			5.0	

[0074]

※ ※【表11】

														. 0
InFa	GaF ₃	ZnF ₂	PbF ₂	BaF ₂	SrF ₂	CdF ₂	MgF ₂	AlFg	YF ₃	LaFa	GdF ₃	LuFg	LF	NaF
25.5	11.5	15.0	120	18.0	8.0				2.5	2.5			5.0	
	11.5			16.0	8.0				25	2.5			5.0	_
25.5				25.0	8.0				2.5	2.5			<u> </u>	5.0
		12.0		35.0	6.0				2.5	2.5			┢	5.0
		12.0		29.0	12.0				25	2.5				5.0
	11.5			16.0	25.0				2.5	2.5				5.0
	11.5			6.0	35.0				2.5	2.5				5.0
	11.5			18.0	8.0				2.5		2.5		\vdash	17.0
	11.5		_	18.0	89				2.5	2.5			5.0	12.0
		15.0		18.0	B.0				2.5	2.5			5.0	_
	11.5		5.0	18.0	8.0				2.5	2.5	_		5.0	7.0
	11.5			18.0	8.0				2.5	2.5				15.0
		12.0		18.0	3.0				2.5	2.5			5.0	_
	11.5			18.0					2.5	2.5				30.0
		15.D		18.0	8.0				2.5	2.5			5.0	
	11.0	15.0	25.0	9.0	4.0				2.5	2.5			5.0	
29.0	8.0	15.0		9.0	4.0			\neg	2.5	2.5			5.0	_
29.0	8.0	15.0	20.0	14.0	4.0			$\neg \neg$	2.5		2.5		5.0	
29.0	8.0	15.0		19.0	4.0				2.5			2.5	5.D	
29.0	8.0	15.0	10.0	24.0	4.0				2.5	2.5			5.0	
29.0	8.0	15.0	5.0	29.0	4.0				2.5	2.5			5.0	
29.0	8.0	15.0		14.0	4.0				2.5	2.5			5.0	20
29.0	8.0	15.0		18.0	8.0				2.5	25			5.0	12
32.0	5.0		25.0	9.0	4.0				2.5	2.5			5.0	
35.5	1.5		25.0	9.0	4.0				2.5	25		\neg	5.0	
35.5	1.5	15.0		9.0	4.0				2.5	2.5			_	25.0
											$\overline{}$			

【0075】(比較例3)本比較例においては、実施例 2の光ファイバ増幅器の構成において、第1の光増幅用 ファイバとしてPbF2 / InF3 系フッ化物光ファイ バを、また、第2の光増幅用ファイバとしてテルライト ファイバを配置した構成を有する光ファイバ増幅器を構 成した。本比較例の構成による利得スペクトルを測定し たところ、波長1. 285~1. 345 μmにわたって 20 d Bの利得が得られており、従来のスペクトルに較 べ増幅帯域が拡大されていることが確認されたが、雑音 指数は波長1.32μmよりも長波長側で劣化してお り、本比較例による雑音指数の改善は認められなかっ た。

【0076】 (実施例3) 本実施例においては、図7に 示したような第1、第2、第3の光増幅用ファイバを直 列に接続した構成を有する光ファイバ増幅器を作製し た。図中、11は第1の光増幅用ファイバ、12は第2 の光増幅用ファイバ、13は第3の光増幅用ファイバ、 3はアイソレータ、4はファイバ型WDMカプラ、4' はバルク型WDMカプラ、5は励起光源である。

イバとしてテルライトファイバを用い、第2の光増幅用 ファイバとしてカルコゲナイドファイバを用い、第3の 光増幅用ファイアとしてZrF4系フッ化物光ファイバ を用い、各ファイバの諸元としては、実施例1および2 で用いたファイバの諸元と同様のものを用いた。 該光フ ァイバ増幅器の利得スペクトルを測定したところ、波長 1. 28~1. 345μmにわたって、20dB以上の 利得と5dBの低い雑音指数を確認することができた。 この他、第1、第2の光増幅用ファイバを入れ替えた場 合においても同様の増幅帯域と雑音指数を確認すること*50 れるが、 $1.29 \sim 1.35$ μ mにわたる波長範囲にお

*ができた。また、第3の光増幅用ファイバとしてPbF 2 / I n F3 系フッ化物光ファイバを用いた場合、(テ ルライトファイバ+カルコゲナイドファイバ+PbF2 /I n F3 系ファイバ) あるいは (カルコゲナイドファ イバ+テルライトファイバ+PbF2 /InF3 系ファ イバ) の構成において、同様の増幅帯域と雑音指数を確 認することができた。

【0078】 (実施例4) 本実施例においては、図8に 示したような第1、第2の光増幅用光ファイバを並列に 30 接続した構成を有する光ファイバ増幅器を開発した。こ こで、11は第1の光増幅用ファイバ、12は第2の光 増幅用ファイバ、3はアイソレータ、4はファイバ型W DMカプラ、4′はバルク型WDMカプラ、5は励起光 源、6は減衰器である。

【0079】 本実施例においては、第1の光増幅用光フ ァイバとしてPr添加カルコゲナイドファイバを、第2 の光増幅用ファイバとしてPr添加PbF2 /InF3 系ファイバを用いた。本実施例においては、図に示した バルク型WDMカプラ4′に用いるフィルタを誘電多層 【0077】本実施例においては、第1の光増幅用ファ 40 膜フィルタとし、波長1.28~1.32μ mまでの信 号光は第2の光増幅用ファイバを通り、波長1.32~ 1.36 μmの信号光は第1の光増幅用ファイバを通る 構成とした。また、第1、第2の光増幅用ファイバの利 得の値を等しくするために、減衰器7をそれぞれ光増幅 用ファイバの後段に配置した。

> 【0080】図9に、入射信号光量-30dBmの場合 に得られた利得スペクトルを示す。図は、左縦軸に利得 を、横軸に波長を示している。図から、用いたフィルタ の損失が増加する1.32 μm付近に利得の減少が見ら

いて平坦な利得特性が得られていることがわかる。ま た、図9右縦軸に雑音指数を示した。雑音指数はフィル タの損失が増加する1.32μm付近において増加して いるが、その他の波長範囲においては5dBの雑音指数 が得られていることがわかる。

【0081】(実施例5)本実施例においては、実施例 1で用いた光ファイバ増幅器の構成において、第1の光 増幅用ファイバとしてPr添加カルコゲナイドファイバ を用い、第2の光増幅用光ファイバとしてDy添加カル コゲナイドファイバを用いて、光ファイバ増幅器を作製 10 した。入射信号光量-30dBmに対する利得スペクト ルを測定したところ、波長1.25~1.4 µmにわた って利得を確認することができた。また、第2の光増幅 用ファイバとして、Dy添加テルライトファイバ、Zr F4系ファイバ、PbF2 / InF3 系ファイバを用い た場合においても、同様の広い増幅帯域を確認すること ができた。

【0082】 (実施例6) 本実施例においては、実施例 1で用いた光ファイバ増幅器の構成において、第1の光 増幅用ファイバとしてNd添加カルコゲナイドファイバ 20 を用い、また、第2の光増幅用光ファイバとしてDy添 加カルコゲナイドファイバを用いて、光ファイバ増幅器 を作製した。入射信号光量-30dBmに対する利得ス ペクトルを測定したところ、波長1.2~1.4 μ mに わたって利得を確認することができた。また、第2の光 増幅用ファイバとして、Dy添加テルライトファイバ、 ZrF4 系ファイバ、PbF2 /InF4 系ファイバ を、あるいはPr添加ZrF4系ファイバ、PbF2/ InF3 系ファイバを用いた場合、さらに第1の光増幅 用ファイバとして、Nd添加テルライトファイバ、石英 30 4,4′ WDMファイバカプラ 系ファイバ、石英系結晶化ファイバを用いた場合におい ても、同様の広い増幅帯域を確認することができた。

[0083]

【発明の効果】以上の実施例に示したように、本発明に よれば低雑音で広帯域な光ファイバ増幅器が構成できる ので、1.3 m帯光通信システムの高度化および低コ スト化が図れるという利点がある。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の光ファイバ増幅器を構成するPr添加 カルコゲナイドファイバ、テルライトファイバ、PbF 2 / InF3 系ファイバ、ZrF4 系ファイバの蛍光ス ペクトルを示す図である。

【図2】本発明の実施例1の光ファイバ増幅器の構成を 示す図である。

【図3】本発明の実施例1の光ファイバ増幅器の利得ス ペクトルを示す図である。

【図4】本発明の比較例1の光ファイバ増幅器の利得ス ペクトルを示す図である。

【図5】本発明の比較例2の光ファイバ増幅器の利得ス ペクトルを示す図である。

【図6】本発明の実施例2の光ファイバ増幅器の利得ス ペクトルを示す図である。

【図7】本発明の実施例3の光ファイバ増幅器の構成を 示す図である。

【図8】本発明の実施例4の光ファイバ増幅器の構成を 示す図である。

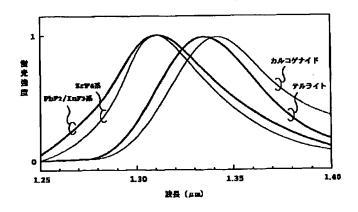
【図9】本発明の実施例4の光ファイバ増幅器の利得ス ペクトルを示す図である。

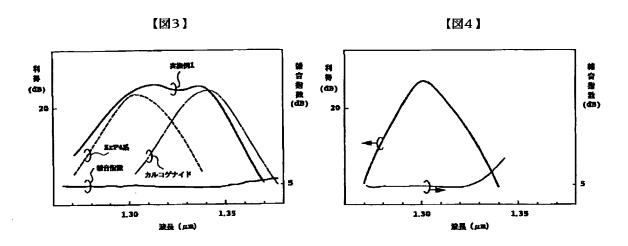
【符号の説明】

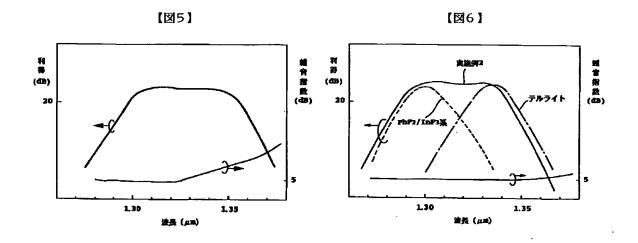
11, 12, 13 第1, 第2, 第3の光増幅用ファイ バ

- 3 アイソレータ
- - 5 励起光源
 - 6 減衰器

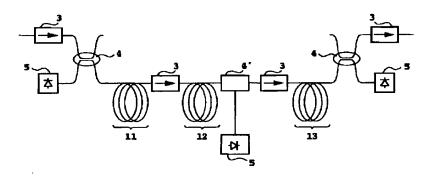
【図1】



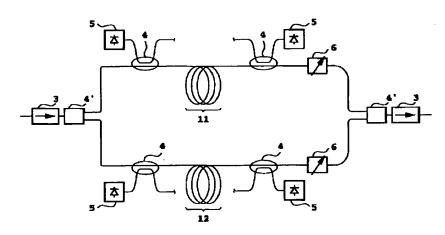




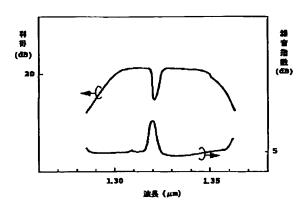
【図7】



【図8】







フロントページの続き

(72)発明者 森 淳 東京都新宿区西新宿三丁目19番2号 日本 電信電話株式会社内 (72)発明者 大石 泰丈 東京都新宿区西新宿三丁目19番2号 日本 電信電話株式会社内